



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H2907A

对应国外型号

KTN2907A

主要用途

放大、开关应用。

极限值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150 $^{\circ}\text{C}$
T_j ——结温	150 $^{\circ}\text{C}$
P_C ——集电极耗散功率	625mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压	-60V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	-60V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	-5V
I_C ——集电极电流	-600mA

外形图及引脚排列

TO-92



- 1—发射极, E
2—基极, B
3—集电极, C

电参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-60			V	$I_C=-10\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-60			V	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10\mu\text{A}$, $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	nA	$V_{\text{CB}}=-50\text{V}$, $I_E=0$
$H_{\text{FE}}(1)$	直流电流增益	75				$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_C=-0.1\text{mA}$
$H_{\text{FE}}(2)$		100		300		$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_C=-150\text{mA}$
$H_{\text{FE}}(3)$		50				$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat}1)$	集电极—发射极饱和电压			-0.4	V	$I_C=-150\text{mA}$, $I_B=-15\text{mA}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat}2)$				-1.6	V	$I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{sat}1)$	基极—发射极饱和电压			-1.3	V	$I_C=-150\text{mA}$, $I_B=-15\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{sat}2)$				-2.6	V	$I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$
f_T	特征频率	200			MHz	$V_{\text{CE}}=-20\text{V}$, $I_C=-50\text{mA}$, $f=100\text{MHz}$
C_{ob}	共基极输出电容			8	pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$
t_{ON}	导通时间			45	ns	$V_{\text{CC}}=-30\text{V}$, $I_C=-150\text{mA}$, $I_{\text{B}1}=-15\text{mA}$
t_{D}	延迟时间			10	ns	
t_{R}	上升时间			40	ns	
t_{OFF}	关闭时间			100	ns	
t_{STG}	贮存时间			80	ns	$V_{\text{CC}}=-6\text{V}$, $I_C=-150\text{mA}$, $I_{\text{B}1}=I_{\text{B}2}=-15\text{mA}$
	下降时间			30	ns	



